

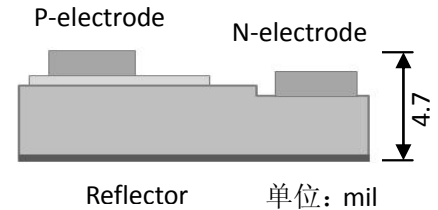
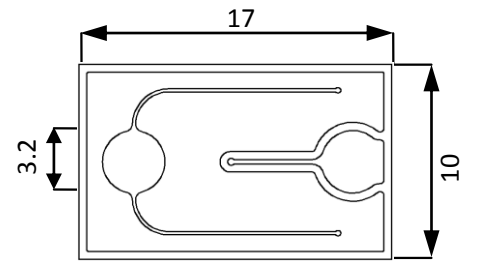
◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性
- DBR/SD 工艺

N*, **, ***, *17A

◆ 物理参数:

芯片尺寸	10mil × 17mil (254 ± 25 μm × 430 ± 25 μm)
芯片厚度	4.7mil (120 ± 5 μm)
焊盘尺寸	3.2mil (80 ± 10 μm) in diameter
P 电极	金
N 电极	金



◆ 光电参数: (Tc=22°C, I_F=60mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =7V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
** A* *** B17A	447.5	450	≤ 3.4	≤ 1	≤ 30	150
** A* *** C17A	450	452.5				
** A* *** D17A	452.5	455				
** A* *** E17A	455	457.5				
** A* *** F17A	457.5	460				
** A* *** G17A	460	462.5				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, I_F=60mA)

等级	...	P72	P76	P80	P84	P88	P92	P96	100	...
P _o (mW)	...	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	...

◆ 其他说明:

- 光电参数均系新纳晶光电测试仪器在晶圆条件下的测试数据, 99%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 0.5nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片

网址: www.nanojoin.com